

2SA1116

■シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形トランジスタ

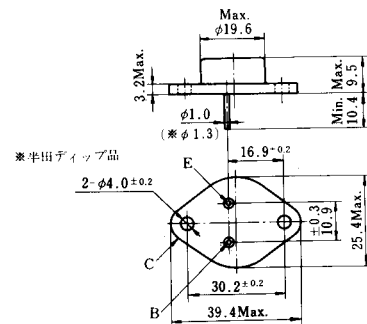
○一般用

☆2SC2607とコンプリメンタリペアになります。

■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SA1116
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-200V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	-200V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6V
コレクタ電流	I _C	-15A
ベース電流	I _B	-5A
許容コレクタ損失	P _C	150W (フランジ温度25°C)
接合部温度	T _j	150°C
保存温度	T _{stg}	-65~+150°C

外形寸法 (単位: mm)
JEDEC(TO-3), EIAJ(TC-3, TB-3)



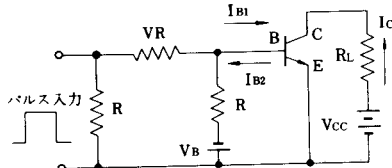
■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SA1116
最大コレクタしゃ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = -200V	-100 μA
最大エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -6V	-100 μA
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = -50mA	-200V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = -4V I _C = -5A	30 Min.
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -10A I _B = -1A	-3.0V Max.
しゃ断周波数	f _t	V _{CE} = -12V I _E = 0.5A	20 MHz Typ.

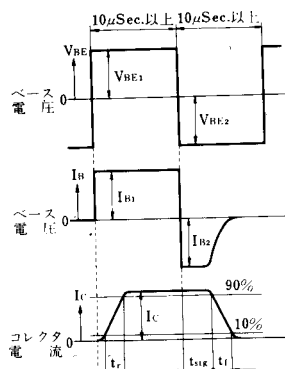
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
-60	12	-5	-500	500	0.3	0.9	0.2

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

